

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和6年3月15日(2024.3.15)

【公開番号】特開2022-139255(P2022-139255A)

【公開日】令和4年9月26日(2022.9.26)

【年通号数】公開公報(特許)2022-176

【出願番号】特願2021-39546(P2021-39546)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)
 B 24 B 1/04 (2006.01)
 B 24 B 9/00 (2006.01)
 B 24 B 7/22 (2006.01)
 B 24 B 53/12 (2006.01)
 B 24 B 53/04 (2012.01)
 B 24 B 49/12 (2006.01)

10

【F I】

H 01 L 21/304 6 2 1 E
 B 24 B 1/04 C
 B 24 B 9/00 6 0 1 H
 B 24 B 7/22 Z
 B 24 B 53/12 Z
 B 24 B 53/04
 B 24 B 49/12

20

【手続補正書】

【提出日】令和6年3月6日(2024.3.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

30

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

【図1】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置を示す平面図である。

【図2】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置のエッジトリミング装置を示す正面図である。

【図3】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置のエッジトリミング装置を示す平面図である。

【図4】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置の撮像装置の画像データを示す図である。

【図5】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す図であり、図5(a)は、チャッキング工程で半導体デバイスウェーハが準備される状態、図5(b)は、エッジトリミング工程でトリミングが行われている状態、図5(c)は、エッジトリミング工程が完了した状態、図5(d)は、薄層化工程で薄層化が行われた状態を示す図である。

【図6】本発明の実施形態に係るトリミング面の近傍を示す図であり、図6(a)は、エッジトリミング工程が完了した状態、図6(b)は、薄層化工程で薄層化が行われた状態を示す図である。

【図7】本発明の他の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す図であり、図7(a)は、チャッキング工程で半導体デバイスウェーハが準備される状態、図7(b)は、エッジトリミング工程でトリミングが行われている状態、図7(c)は、エッジトリミング工

40

50

程が完了した状態、図 7 (d) は、薄層化工程で薄層化が行われた状態を示す図である。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 5】

